

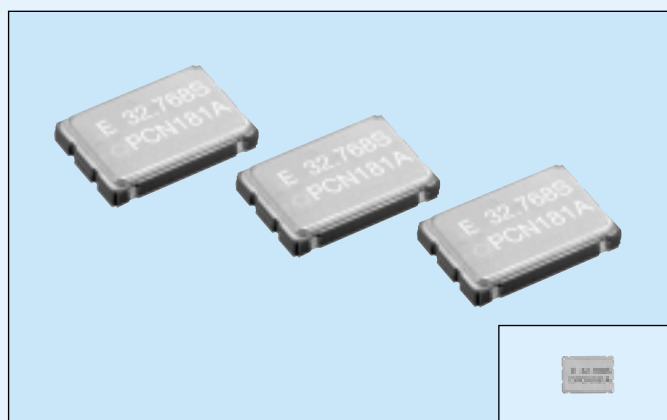
高周波水晶発振器

SG-730シリーズ

製品型番 (2ページを参照)

Q33730xxxxxxx00

- リフロー可能な高密度実装対応SMD.
- C-MOS ICの使用により低消費電流を実現
- 電源電圧5.0V(*H*)、3.3V(*C*) 対応
- Output enable(OE)機能により消費電力の低減可能



原寸大

■仕様 (特性)

項目	記号	仕様			条件
		PHN	PCN	SCN	
出力周波数範囲	f_0	1.5000 MHz~67.0000 MHz		67.0001 MHz ~80.0000 MHz	P.31製品別周波数帯を参照してください
電源電圧	最大供給電圧 V_{DD-GND}	-0.5 V~+7.0 V			$V_{DD}=GND$
	動作電圧 V_{DD}	H: 5.0 V \pm 0.5 V	C: 3.3 V \pm 0.3 V		
温度範囲	保存温度 T_{STG}	-40 °C~+125 °C			単品で保存
	動作温度 T_{OPR}	-40 °C~+85 °C			P.31製品別周波数帯を参照してください
周波数安定度	$\Delta f/f_0$	S: $\pm 25 \times 10^{-6}$ Max., B: $\pm 50 \times 10^{-6}$ Max., C: $\pm 100 \times 10^{-6}$ Max.			-20 °C~+70 °C
		L: $\pm 50 \times 10^{-6}$ Max., M: $\pm 100 \times 10^{-6}$ Max.			-40 °C~+85 °C
消費電流	I_{OP}	12.0 mA Max.	7.0 mA Max.	-	$F_0 \leq 32$ MHz, 無負荷
		30.0 mA Max.	12.0 mA Max.	-	$F_0 \leq 40$ MHz, 無負荷
		40.0 mA Max.	15.0 mA Max.	-	$F_0 \leq 50$ MHz, 無負荷
		50.0 mA Max.	20.0 mA Max.	-	$F_0 \leq 67$ MHz, 無負荷
		-	-	35 mA Max.	$F_0 \leq 80$ MHz, 無負荷
ディセーブル電流	I_{OE}	5.0 mA Max.	4.0 mA Max.	-	$F_0 \leq 32$ MHz, OE=GND (PHN,PCN)
		25.0 mA Max.	10.0 mA Max.	-	$F_0 \leq 40$ MHz, OE=GND (PHN,PCN)
		30.0 mA Max.	10.0 mA Max.	-	$F_0 \leq 50$ MHz, OE=GND (PHN,PCN)
		40.0 mA Max.	10.0 mA Max.	-	$F_0 \leq 67$ MHz, OE=GND (PHN,PCN)
スタンバイ時電流	I_{ST}	-	-	15 μ A Max.	$\overline{ST}=GND$ (SCN)
デューティ	t_w/t	45 %~55 %			1 / 2 V_{DD} レベル
"H" レベル出力電圧	V_{OH}	$V_{DD} - 0.4$ Min.			$I_{OH}=8$ mA
"L" レベル出力電圧	V_{OL}	0.4 V Max.			$I_{OL}=8$ mA
出力負荷条件	C_L	15 pF Max.			
"H" レベル入力電圧	V_{IH}	2.0 V Min.	2.0 V Min.	70% V_{DD} Min.	OE端子 (PCN PHN) ST端子 (SCN)
"L" レベル入力電圧	V_{IL}	0.8 V Max.	0.5 V Max.	30% V_{DD} Max.	
出力上昇時間	t_{rLH}	4 ns Max.			20 % \rightarrow 80 % V_{DD} レベル
出力下降時間	t_{rHL}	4 ns Max.			80 % \rightarrow 20 % V_{DD} レベル
発振開始時間	t_{OSC}	10 ms Max.			最小値動作電圧時のtを0とする。
経時変化	f_a	$\pm 10 \times 10^{-6}$ / 年 Max.			$T_a=+25$ °C, $V_{DD}=5.0$ V/3.3 V, 10 years

■外形寸法図

(単位: mm) ■推奨はんだ付けパターン図 (単位: mm)

